

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.06.2026 10:43:12
Уникальный идентификатор:
04c19ed8b0587180e574483b5ad78088922529



МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Оптоэлектроника и системы технического зрения» по направлению подготовки (специальности) 03.04.03 «Радиофизика» в направлении (профиль) «Электронные и информационные устройства робототехнических систем»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

**Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)
Оптоэлектроника и системы технического зрения**

**Направление подготовки (специальность)
03.04.03. Радиофизика**

**Направленность (профиль)
Электронные и информационные устройства робототехнических систем**

**Присваиваемая квалификация (степень)
Магистр**

**Форма обучения
Очная**

Год набора 2026

Челябинск, 2026 г.



Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Перечень формируемых компетенций
 - 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
3. Содержание оценочных средств по дисциплине
 - 3.1. Виды оценочных средств
 - 3.2. Содержание оценочных средств
4. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации
 - 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации
 - 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств
 - 4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 03.04.03 Радиофизика

Направленность (профиль): Электронные и информационные устройства робототехнических систем

Дисциплина: Оптоэлектроника и системы технического зрения

Семестр: 1

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Система оценивания: оценивание результатов осуществляется в рамках 5-балльной системы

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Оптоэлектроника и системы технического зрения» направлено на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Содержание компетенций согласно ФГОС	Индикаторы достижения компетенций согласно ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1	Способность использовать в своей научно-исследовательской деятельности знание принципов работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной аппаратуры и оборудования	ПК-1.1. Обладает знаниями в своей области научно-исследовательской деятельности о принципах работы, устройстве, технических возможностях радиоизмерительного оборудования; контроле технического состояния радиоэлектронных систем и перспективы их совершенствования; способах настройки радиоэлектронных систем; технологии автоматической обработки информации; методах и способах калибровки контрольно-измерительных приборов. ПК-1.2. Демонстрирует умение настройки, диагностики и оценки технического состояния радиоэлектронных систем в своей научно-исследовательской деятельности. ПК-1.3. Имеет практический опыт (навыки) использования в своей научно-	Для достижения индикатора ПК-1.1: Знать в своей области научно-исследовательской деятельности о принципах работы, устройстве, технических возможностях радиоизмерительного оборудования; контроле технического состояния радиоэлектронных систем и перспективы их совершенствования; способах настройки радиоэлектронных систем; технологии автоматической обработки информации; методах и способах калибровки контрольно-измерительных приборов. Для достижения индикатора ПК-1.2: Уметь производить настройки, диагностики и оценки технического состояния радиоэлектронных систем в своей научно-исследовательской деятельности. Для достижения индикатора ПК-1.3: Владеть навыками использования в своей научно-исследовательской деятельности тестирования работы, настройки, мониторинга технического состояния, устранения неисправностей и проверки функционирования радиоэлектронных систем.



		исследовательской деятельности тестирования работы, настройки, мониторинга технического состояния, устранения неисправностей и проверки функционирования радиоэлектронных систем.	
--	--	---	--

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1 Виды оценочных средств

№ п/п	Код компетенции	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для текущего контроля	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/№ задания
1.	ПК-1	Характеристики полупроводников Полупроводниковые квантовые структуры	Реферат	Вопросы к экзамену (№1 – 4)
		Электронные приборы на наноструктурах	Реферат	Вопросы к экзамену (№5 – 11)
		Оптические процессы в квантовых наноструктурах	Реферат	Вопросы к экзамену (№8 – 17)
		Светоизлучающие и лазерные диоды	Реферат	Вопросы к экзамену (№11 – 21)
		Оптоэлектронные системы	Реферат	Вопросы к экзамену (№22 – 25)
		Электронные приборы на наноструктурах	Реферат	Вопросы к экзамену (№9 – 12)
		Оптические процессы в квантовых наноструктурах	Реферат	Вопросы к экзамену (№12 – 18)
		Светоизлучающие и лазерные диоды	Реферат	Вопросы к экзамену (№18 – 21)
		Оптоэлектронные системы	Реферат	Вопросы к экзамену (№22 – 25)
Системы технического зрения	Реферат	Вопросы к экзамену (№26 – 30)		



3.2 Содержание оценочных средств

Примерные темы рефератов:

1. Многослойные диэлектрические покрытия. Применение в п/п лазерах.
2. Квантово-каскадные лазеры.
3. Лазеры с вертикальным резонатором.
4. Лазер на активной волноводной структуре.
5. Лазер с распределенной обратной связью.
6. Сверхяркие светодиоды.
7. Светодиоды белого свечения.
8. Светодиоды в волоконно-оптических системах связи.
9. Светодиоды с резонатором.
10. Светочувствительные ПЗС-матрицы.
11. Светочувствительные КМОП-матрицы.

Критерии оценивания реферата:

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Реферат оценивается руководителем исходя из установленных показателей и критериев оценки реферата:

1) Новизна реферированного текста (Макс. - 5 баллов)

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2) Степень раскрытия сущности проблемы (Макс. - 5 баллов)

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.

3) Обоснованность выбора источников (Макс. - 5 баллов)

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4) Соблюдение требований к оформлению (Макс. - 5 баллов)

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

5) Грамотность (Макс. - 5 баллов)

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;



- литературный стиль

Реферат оценивается по 25 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

15 баллов и выше - "зачтено"

меньше 15 баллов - "не зачтено"

Рекомендации по написанию реферата:

1) Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента и не обязательно должна соответствовать приведенному примерному перечню. Важно, чтобы в реферате были освещены стороны проблемы, а также представлены теоретические положения и конкретные примеры.

2) Реферат должен основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе источников. Как правило это научные монографии или статьи.

3) План реферата должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его мнение, анализ проблемы.

4) Все приводимые в реферате факты и заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник информации.

5) Недопустимо просто скопировать реферат из кусков заимствованного текста. Все цитаты должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках источника и страницы.

6) Реферат оформляется в виде текста на листах формата А-4. Работа начинается с титульного листа, в котором указывается название университета, название кафедры, учебной дисциплины, тема реферата, ФИО студента, номер группы, год и географическое место местонахождения университета. Затем следует оглавление с указанием страниц разделов. Сам текст реферата желательно подразделить на разделы: главы, подглавы и озаглавить их. Приветствуется использование в реферате количественных данных и иллюстраций (графики, таблицы, диаграммы, рисунки).

7) Завершают реферат разделы «Заключение» и «Список использованной литературы». В заключении должны быть представлены основные выводы, ясно сформулированные в тезисной форме.

8) Источник литературы должен быть составлен в полном соответствии с действующим стандартом (правилами), включая особую расстановку знаков препинания.

Вопросы к экзамену:

1. Статистика носителей заряда в полупроводниках. Квазиуровни Ферми в неравновесной системе.

2. Распределение электронов и дырок в зонах.

3. Поглощение и спонтанное излучение. Условия оптического усиления в полупроводниках.

4. Квантовая яма. Распределение электронов в квантовых ямах. Уравнение Шредингера.

5. Формирование квантовых ям. Гетеропереходы. Множественные квантовые ямы. Сверхрешетки.

6. Процессы переноса в квантовых наноструктурах под действием электрического поля. Продольный перенос, механизмы рассеяния электронов.

7. Поперечный перенос: резонансное туннелирование, влияние электрических полей на свойства сверхрешеток.

8. Оптические переходы между валентной зоной и зоной проводимости Оптические межзонные переходы в квантовой яме. Оптические межподзонные переходы в квантовой яме.

9. Квантово-размерный эффект Штарка.



10. Электронные приборы на наноструктурах. Структуры полевых МОП-транзисторов (MOSFET). Модулированно-легированные полевые транзисторы (MODFET).
11. Биполярные транзисторы на гетеропереходах. Транзисторы на горячих электронах. Транзисторы с резонансным туннелированием.
12. Квантово-размерные фотоприемники. Лавинные фотоприемники.
13. Распределение носителей в фотовозбужденном полупроводнике. Фоточувствительность фотопроводника.
14. Шум фотоприемника. Физическая природа шума.
15. Шум фотоприемника. Тепловой, генерационно-рекомбинационный шум, шум умножения.
16. Пределы обнаружительной способности фотоприемников.
17. Обнаружительная способность фотопроводника и фотодиода.
18. Спектральные и оптические характеристики оптоэлектронных приборов.
19. Электролюминесцентные диоды. Внутренняя и внешняя эффективность СИД.
20. Оптическое усиление в диодах с гетеропереходами. Лазерные диоды с двойным гетеропереходом. Лазерный порог. Выходная мощность.
21. Квантово-размерные лазерные диоды. Порог прозрачности. Лазерный порог. Характеристики излучения лазерного диода.
22. Интегральная оптоэлектроника. Фотоэлектрические интегральные схемы.
23. Схемотехника оптронов. Оптроны в аналоговых и цифровых схемах.
24. ПЗС-формирователи изображения.
25. Системы оптической связи. Волоконно-оптические линии передачи информации.
26. Основные виды систем технического зрения.
27. Области применения и специфика эксплуатации систем технического зрения.
28. Особенности аппаратных и программных средств технического зрения.
29. Способы организации и проведения экспериментальных исследований в области систем технического зрения.
30. Способы исследования и тестирования систем технического зрения различного назначения.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Студент допускается к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполненных и защищенных работ. В случае наличия учебной задолженности студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и представленной в настоящей программе.

Экзамен проводится по билетам в устной форме. При проведении экзамена экзаменуемый выбирает билет в случайном порядке. Экзаменатору предоставляется право по ходу экзамена задавать экзаменуемому уточняющие и дополнительные вопросы. Время подготовки студента для устного ответа на экзамене должно составлять не менее 40 минут, время ответа экзаменуемого – не более 20 минут. При подготовке и ответе на вопросы билета экзаменуемый должен вести необходимые записи в листе устного ответа, который по окончании экзамена подписывается студентом, сдаётся экзаменатору и сохраняется им до окончания экзаменационной сессии. Студент, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, вправе выбрать второй билет с продлением времени на подготовку. При этом окончательная оценка студента снижается на один балл. Выбор



студентом третьего билета не допускается.

Проявленные студентом в ходе экзамена знания оцениваются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств

Критерии оценивания ответа (устного опроса) на экзамене:

Оценка «отлично» выставляется:

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знания по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.

Оценка «хорошо» выставляется:

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены некоторые неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется:

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется:

1) Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.

2) Ответ на вопрос полностью отсутствует.

3) Отказ от ответа.

Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины (модуля).

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично».
2. Средний уровень сформированности компетенций соответствует оценке «хорошо».
3. Базовый уровень сформированности компетенций соответствует оценке «удовлетворительно».
4. Низкий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «неудовлетворительно».

